N THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Art Unit: 2816

In re application of:

SHIMADA, et al.

Serial No: 10/628,881

Filed: July 28, 2003

Surface Acoustic Wave Device and

Method for Manufacturing Same

TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT

Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States

Postal Service with sufficient postage as

first class mail in an envelope addressed

Examiner: Not Assigned

Commissioner for Patents P.O. Box 1450

Alexandria, VA 22313-1450, on

January 24, 2004 Date of Deposit

Shindale Ferguson

January 14, 2004

Enclosed herewith is a certified copy of Japanese patent application Nos. 2002-222582 and 2002-222583, which were filed July 31, 2002; Nos. 2002-316788; 2002-316791; and 2002-316792, which were filed October 30, 2002; and Nos. 2003-021101 and 2003-021104, which were filed January 29, 2003, from which priority is claimed under 35 U.S.C. § 119 and Rule 55.

Acknowledgment of the priority document(s) is respectfully requested to ensure that the subject information appears on the printed patent.

Respectfully submitted,

HOGAN

Date: January 14, 2004

Anthony J. Orler

Registration No. 41,232 Attorney for Applicant(s)

500 South Grand Avenue, Suite 1900

Los Angeles, California 90071

Telephone: 213-337-6700 Facsimile: 213-337-6701

# 日本 国 特 許 庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年 7月31日

出 願 番 号

Application Number:

特願2002-222582

[ ST.10/C ]:

[JP2002-222582]

出 願 人
Applicant(s):

京セラ株式会社

2003年 5月20日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



## 特2002-22582

【書類名】

特許願

【整理番号】

27044

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

H03H 9/145

【発明者】

【住所又は居所】

鹿児島県国分市山下町1番1号 京セラ株式会社鹿児島

国分工場内

【氏名】

鳥田 光隆

【特許出願人】

【識別番号】

000006633

【住所又は居所】

京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地

【氏名又は名称】

京セラ株式会社

【代表者】

西口 泰夫

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

005337

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要

## 【書類名】 明細書

【発明の名称】 弾性表面波装置

# 【特許請求の範囲】

【請求項1】タンタル酸リチウム圧電基板の一主面上にインターデジタルトランスデューサー電極、該インターデジタルトランスデューサー電極と接続をする接続電極及び外周封止電極が形成された弾性表面波素子と、

ハンダバンプ部材を介して前記接続電極と接続する素子接続用電極、ハンダ接合部材を介して前記外周封止電極と接合する外周封止導体膜及び外部端子電極を 形成されたベース基板と、

該ベース基板の主面と前記弾性表面波素子の一主面との間に所定間隙を形成するように、前記ベース基板の主面に接続・固定した弾性表面波素子の他主面及び側面に被着された外装樹脂層とからなる弾性表面波装置において、

前記ハンダバンプ部材及びハンダ接合部材は、90%以上のSnを含むSn-Sb系またはSn-Ag系の無鉛ハンダであるとともに、前記ベース基板の熱膨 張係数が、9~20ppm/℃であることを特徴とする弾性表面波装置。

【請求項2】 前記ベース基板が、セラミック粉末と該セラミック粉末の界面に結晶化ガラスが配されたガラスセラミックであることを特徴とする請求項1記載の弾性表面波装置。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

## 【発明の属する技術分野】

インターデジタルトランスデューサー電極(以下、単にIDT電極と記す)及び接続電極が形成された弾性表面波素子をベース基板に接合・固定した弾性表面波装置に関するものである。

[0002]

#### 【従来の技術】

従来、弾性表面波素子は、図6に示すように、キャビティ63が形成されたベース基板62に、弾性表面波素子61を接合して、このキャビティ62の開口を 封止用金属蓋体64などで覆っていた。 [0003]

このような弾性表面波装置の弾性表面波素子61は、タンタル酸リチウム基板、ニオブ酸リチウム基板などの単結晶圧電基板一方主面にIDT電極を形成し、さらに、このIDT電極に接続をする接続電極を形成していた。

[0004]

これらのIDT電極や接続電極は、圧電基板上に薄膜技法を用いてアルミニウムなどで形成していた。

[0005]

また、ベース基板62は、たとえばアルミナセラミックなどからなり、ベース 基板62の一方主面には、キャビティ63が形成されている。このキャビティ6 3の底面には、素子接続用電極が配置されており、この素子接続用電極は、ベース基板62の底面に形成した外部接続電極と接続している。また、キャビティ6 3の開口周囲は、封止導体膜が形成さており、その封止導体膜にシールリング6 5が固定されている。

[0006]

このような弾性表面波素子61とベース基板62の接続にあたっては、弾性表面波素子の接続電極上に金ワイヤのボールボンディングによる金バンプ66を形成して、この金バンプ66とベース基板62の素子接続用電極と当接するように、キャビティ63内に弾性表面波素子61を配置し、その後、弾性表面波素子61に超音波を印加して融着していた。

[0007]

その後、キャビティ63内を所定雰囲気に制御して、キャビティ63開口周囲に固定したシールリング65を介して金属蓋体64を配置して、金属蓋体64をシーム溶接により封止していた。

[0008]

なお、ベース基板62は、周知の多層配線基板の製造方法と同様であり、キャビティ63はベース基板62を構成する上部側のアルミナ絶縁層の枠形状により構成することができ、また、素子接続用電極は、アルミナ絶縁層間に配置された配線パターンの一部として形成することができる。そして、その配線パターン(

素子接続用電極)の表面は、上述の超音波融着を容易にするために、金メッキ層 などが被着されている。

[0009]

このような金バンプ66は、ボールボンディング法を用いて圧電基板の接続電極上に形成するため、ボンディングダメージを与えてしまう。また、実装にあたっては、弾性表面波素子に直接、超音波熱圧着により接合しており、基板加熱温度を150℃程度に加熱し、素子側から荷重は1~10N程度を印加して行う。即ち、また、加熱処理を伴うため、基板が熱膨張により変形し、この変形した応力が内在した状態で弾性表面波素子が接合・固定されてしまい、常温における弾性表面波素子の特性を変動させてしまう。

[0010]

また、弾性表面波素子に超音波振動をあたえるため、物理的な影響をあたえてしまい、極端な場合には圧電基板から接続電極が剥離してしまう。

また別の構造として、弾性表面波素子とベース基板との接続及び機械的な接合 を金バンプ以外にハンダパンプを用いた構造が既に知られている。

[0011]

そして、弾性表面波素子61とベース基板62との接合のハンダには、一般的には、Pb/Sn(たとえは95Pb/5Sn)が用いられていた。

[0012]

この構造では、弾性表面波素子の接続においては、弾性表面波素子に超音波振動を印加する必要がないため、弾性表面波素子への物理的なダメージを極端に抑えることができる。また、半田リフロー処理などの加熱処理で行われるが、ハンダの鉛成分が基板側の熱膨張係数と弾性表面波素子側の熱膨張係数の差による応力を吸収する機能を有していた。これは、ハンダを含まれる鉛成分が比較的柔らかい材料であり、熱膨張係数の差による応力が発生しても、この応力を柔らかい材料である鉛で緩和できるためである。即ち、ベース基板の熱膨張係数と弾性表面波素子の熱膨張係数を厳密に考慮する必要がなく、比較的安価で容易な接続が可能といえる。

[0013]

# 【発明が解決しようとする課題】

しかし、接合部材の鉛成分を含有するハンダは、環境悪化を招くことから、その利用が制限されつつある。

#### [0014]

また、超音波による融着に比較して、弾性表面波素子及びベース基板の全体に加熱を行う必要があり、弾性表面波素子とベース基板との間のひずみ量が大きくなる可能性があった。

## [0015]

また、この鉛成分を多量に含むはんだ材料は、降伏応力が低いため、弾性表面 波素子と基板間の熱膨張係数差による熱ストレスが加わった場合には、塑性ひず み量やクリープひずみ量が大きくなる。これは、接合時のみを考えると、上述の ように熱ストレスを吸収できるように思えても、実際の長期使用を想定した温度 サイクル試験を行うと、弾性表面波装素子とベース基板との熱膨張係数の差による応力がハンダ部分に集中し、それが繰り返しかかりハンダ部分で金属疲労を起こし、破断してしまうという致命的な問題があった。

# [0016]

このため、従来では、ベース基板と弾性表面波素子との接合部分の側面部分に 、高粘度コート材を周囲に設けて、はんだ接合部分に発生する応力を緩和させ、 信頼性寿命を確保していた。

## [0017]

さらに、弾性表面波素子をアルミナなどのベース基板に、Pbはんだ以外のろう材を用いると、弾性表面波素子側に熱膨張係数の差による応力が集中してしまい、弾性表面波素子が割れてしまう可能性があり、接合部材については特に慎重に選定する必要がある。

#### [0018]

また、その接合時に、接合部材から、異物が発生するものを避けなくてはならない。これは、異物が弾性表面波素子、特にIDT電極に付着してしまうと、特性劣化を招いてしまうためである。

#### [0019]

特に、圧電基板の材料にタンタル酸リチウムを用いた弾性表面波素子の場合、タンタル酸リチウムの熱膨張係数は、素子の伝搬方向と、伝搬方向と直交する方向では、熱膨張係数が異なるという特性を有する。例えば、表面波伝播方向の線膨張係数は約16ppm/℃、表面波伝播方向と直交する方向の線膨張係数は約8.3ppm/℃である。

## [0020]

また、基板材料はアルミナで熱膨張係数は、方向性の依存性がなく、たとえば 7 p p m / ℃である。即ち、熱膨張係数の方向性の依存のある圧電基板と、方向 依存性のない基板とを、接続するにはその接続構造を十分に考慮しなくてはならない。しかも、圧電基板とベース基板との低背化及び容易な接合を図ったフェイスダウン実装構造(熱膨張係数の応力が接合部で集中する)では特に考慮しなくてはならない。

#### [0021]

また、圧電基板のIDT電極を形成した表面側が、ベース基板への実装面となり、この実装面側に弾性表面波が安定して伝搬できるように所定間隙を形成する必要があり、半導体素子の接合のように、機械的な接合を向上させるため、ベース基板との間に絶縁性樹脂のからなるアンダフィルの使用についても制限が発生してしまう。

## [0022]

本発明は、上述の課題に鑑みて案出されたものであり、その目的は、ベース基板に、タンタル酸リチウムの圧電基板を用いた弾性表面波素子をフェースボンディング接合しても、熱膨張係数の差による熱応力に対して非常に安定して接合でき、しかも、長期にわたり安定した接続が維持できる弾性表面波装置を提供することにある。

#### [0023]

#### 【課題を解決するための手段】

本発明は、タンタル酸リチウム圧電基板の一主面上にインターデジタルトランスデューサー電極、該インターデジタルトランスデューサー電極と接続をする接続電極及び外周封止電極が形成された弾性表面波素子と、

ハンダバンプ部材を介して前記接続電極と接続する素子接続用電極、ハンダ接合部材を介して前記外周封止電極と接合する外周封止導体膜及び外部端子電極を 形成されたベース基板と、

該ベース基板の主面と前記弾性表面波素子の一主面との間に所定間隙を形成するように、前記ベース基板の主面に接続・固定した弾性表面波素子の他主面及び側面に被着された外装樹脂層とからなる弾性表面波装置において、

前記ハンダバンプ部材及びハンダ接合部材は、90%以上のSnを含むSn-Sb系またはSn-Ag系の無鉛ハンダであるとともに、前記ベース基板の熱膨 張係数が、9~20ppm/℃であることを特徴とする弾性表面波装置である。

## [0024]

また、前記ベース基板が、セラミック粉末と該セラミック粉末の界面に結晶化 ガラスが配されたガラスセラミックである。

## 【作用】

本発明では、ベース基板に、タンタル酸リチウムからなる圧電基板を用いた弾性表面波素子を、90%以上のSbを含むSn-Sb系またはSn-Ag系ハンダからなるハンダバンプ及びハンダ接合部材により電気的な接続及び接合をおこなっている。即ち、ハンダバンプ部材により、ベース基板と弾性表面波素子との電気的な接続を行い、またハンダ接合部材により、特に、圧電基板一方主面の周囲で機械的な接合をおこなっている。即ち、超音波融着のように、弾性表面波素子に多大な物理的な衝撃をあたえることがないため、電極の剥離などを招くことが一切ない。

#### [0025]

このハンダバンプやハンダ接合部材に、90%以上のSnを含むSn-Sb系 無鉛ハンダをハンダバンプ及びハンダ接合部材に用いるため、従来の鉛成分を含 有するハンダの接合に比較して、熱膨張係数の差による熱応力による金属疲労を 低減して長期にわたり、安定した接続を維持している。

# [0026]

また、鉛成分を有するハンダに比較して、その熱応力を吸収しにくいものの、タンダル酸リチウムの伝搬方向の熱膨張係数とそれに直交する方向の熱膨張係数

を考慮して、ベース基板の熱膨張係数を厳密に、9~20ppm/℃と規定しているため、ハンダ接合部材で吸収できなかった応力に対しても、弾性表面波素子やベース基板にひずみや反りが発生しない。

[0027]

したがって、実際の使用を想定した温度サイクル試験を施しても、安定した接合が維持できる。

[0028]

また、タンタル酸リチウム圧電基板の一方主面(IDT電極が形成された面) の周囲には、接合用のハンダ接合用部材が周設されている。即ち、弾性表面波素 子とベース基板との間隙が、接合が安定したハンダ部材で取り囲まれているため 、その間が気密的に封止された状態を維持できる。

[0029]

また、熱膨張係数 9 ~ 2 0 p p m / ℃の基板としては、無機物フィラーの界面に結晶化ガラスが充填されたガラスーセラミック基板がなどが例示でき、タンタル酸リチウムの方向性を有する熱膨張係数に対しても、非常に安定して追随することができる。

[0030]

#### 【発明の実施の形態】

以下、本発明の弾性表面波装置を図面に基づいて詳説する。

図1は、本発明の弾性表面波装置の断面図であり、図2は、本発明の弾性表面波装置に用いるベース基板の概略平面図であり、図3は、弾性表面波装置に用いる 弾性表面波素子を製造する各工程における断面図である。

[003.1]

本発明は、弾性表面波素子1、ベース基板2、ハンダバンプ部材3、ハンダ接合部材4、外装樹脂層5とから構成されている。

[0032]

弾性表面波素子1は、弾性表面波共振子、弾性表面波フィルタなどが例示でき、タンタル酸リチウム圧電基板10の一主面上にインターデジタルトランスデューサー電極(本発明では、櫛歯状電極及び反射器電極を含み、以下、単にIDT

電極という) 1 1 が形成され、さらにこのIDT電極 1 1 と接続をする接続電極 1 2 が形成されている。例えば、IDT電極 1 1 は、タンタル酸リチウム圧電基 板 1 0 の中央に、伝搬方向に形成され、接続電極 1 2 は、IDT電極 1 1 の所定 箇所から延びるように、IDT電極 1 1 の周囲に形成される。接続電極 1 2 は、例えば、信号入力電極、信号出力電極、グランド電位電極などからなる。

[0033]

また、このタンタル酸リチウム圧電基板10の一方主面(IDT電極11、接続電極12を形成した面)の外周には、外周封止電極13が形成されている。この外周封止電極13は、弾性表面波素子1とベース基板2との単に形成される間隙の周囲を気密的に封止するものである。なお、各電極11~13は、例えば、アルミニウム、銅などをフォトリソグラフィ技術に基づいて形成され、その表面に、クロム、ニッケル、金などのメッキ層が形成される。

[0034]

ベース基板 2 は、熱膨張係数 9~2 0 p p m / ℃となる基板材料、たとえば、ガラスーセラミック材料の多層基板などが例示できる。このガラスーセラミック材料の基板 2 0 は、アルミナ粉末の無機物フィラーと、この無機物フィラーの界面に結晶化ガラスが配置され基板であり、アノーサイトなどの結晶化ガラスが析出される複数の金属酸化物(ほう酸、シリカ、酸化亜鉛など)の粉末を用いて、有機バインダ、溶剤を均質混練して得られるスラリーを例えばグリーンシート生成して、このグリーンシートを積層した後一体的に焼成して形成される。また、上述のスラリーを支持基板上に印刷し、また、支持基板にコートして積層化して未焼成状態の積層体を形成した後、焼成処理して形成する。ベース基板 2 を構成する基板 2 0 の表面には、素子接続用電極 2 1、外周封止導体膜 2 2 及び外部端子電極 2 3 が形成されている。さらに、素子接続用電極 2 1 と外部端子電極 2 3 とを接続するビアホール導体を含む内部配線パターン 2 4 が形成されている。

[0035]

これらの各導体膜または各電極 2 1 ~ 2 4 は、上述の基板を形成する工程で、 銀などの導電性ペーストをグリーンシートや印刷塗布膜上に形成した貫通孔内に 充填したり、また、グリーンシートや印刷塗布膜の表面に所定形状に印刷して、 積層処理後、基板20の焼成工程で一体的に焼成処理されて形成される。 なお、この素子接続用電極21、外周封止導体膜22及び外部端子電極23は、 銀の導体膜上にメッキ処理などを施して、少なくともハンダ濡れ性が良好な金属 表面を形成する。

[0036]

このようなベース基板 2 上に弾性表面波素子1 を接合するにあたり、ベース基板 2 の主面と弾性表面波素子1 の一主面(I D T電極 1 1 が形成された面)との間に所定間隙を形成するように、弾性表面波素子1 の接続電極 1 2 とベース基板 2 の主面の素子接続用電極 2 1 とをハンダバンプ部材 3 により接続して、弾性表面波素子1 の外周封止電極 1 3 とベース基板 2 の外周封止導体膜 2 2 とをハンダ接合部材 4 によって接合する。そして、ハンダバンプ部材 3 、ハンダ接合部材 4 は、その組成が S n 9 0 %以上の無鉛はんだ材料である S n - S b 系または S n - A g 系のハンダを用いる。即ち、本発明による接合方法は、ハンダによるフェースボンディング接合である。

[0037]

なお、この接合時にあたり、ベース基板2と弾性表面波素子1との間隙が所定 雰囲気、たとえば窒素雰囲気になるように、接合は窒素雰囲気で処理する。

[0038]

また、ベース基板2に接合された弾性表面波素子1は、他方主面側及び側面に わたり、外装樹脂層5を被着形成する。この外装樹脂層5は、エポキシ樹脂、ポ リイミド系樹脂などが例示できる。

[0039]

本発明で特徴的なことは、タンタル酸リチウム圧電基板10を用いた弾性表面 波素子1をフェイスホンディング接合するにあたり、異方性の熱膨張係数を考慮 して、基板20の熱膨張係数を9~20ppm/℃に制御するとともに、このベ ース基板2と弾性表面波素子1との接続及び接合に用いるハンダ組成は、Sn9 0%以上の無鉛はんだ材料を用いたことである。

[0040]

これにより、ハンダバンプ3及びハンダ接合部材4がベース基板2の各電極、

各導体膜21、22上に一括的に形成することができ、大幅なプロセスコストの削減が可能となる。また、ハンダ材料の融点を250℃以下とすることができるため、弾性表面波素子1とベース基板2との間のひずみ量を抑えることができ、弾性表面波素子1にクラックの発生を有効に抑えることができる。したがって、弾性表面波素子1とベース基板2との間の塑性ひずみ量を低減させる効果は顕著となり、長期にわたり高い信頼性を保証できる。さらに、ベース基板2は、水分透過抑制効果のあるガラスーセラミック材料からなる基板20を用いており、各素子接続用電極21、内部配線パターン24などに、銀や銅などの低抵抗材料を用いることができ、高周波特性に優れたものになる。

#### [0041]

また、弾性表面波素子1の圧電基板10の外周の全周にわたり、外周封止電極13が形成され、この部分にベース基板2の外周封止導体膜22とハンダ接合部材4によって接合されている。このため、気密封止性が非常に向上することになり、水分の浸入経路が完全に無くなり気密性が大幅に向上する。

## [0042]

また、気密封止をおこなうハンダ接合部材4と、弾性表面波素子1とベース基板2とを電気的に接続するハンダバンプ部材3とを同一材料に形成することにより、例えば、ベース基板2上にハンダバンプ部材3及びハンダ接合部材4を形成する工程が同一工程内の作業となり、ハンダバンプ部材3による接続及びハンダ封止部材4による接合も同一工程でその作業を行える。

## [0043]

以下、本発明の弾性表面波装置の製造方法に図3(a)~(f)を用いて説明する。

#### [0044]

まず、ベース基板2が複数抽出できる大型ベース基板を用意する。この大型ベース基板の各装置の領域(切断または分割後にベース基板2となる領域)の一方主面には、素子接続用電極21、外周封止導体膜22が形成され、他方主面には、外部端子電極23が形成され、さらに、各素子領域には、内部配線パターン24が形成されている(図3(a)参照)。なお、各基板領域の平面形状は、弾性

表面波素子1の平面形状よりも1周り、たとえば、0.5mm程度大きくしておくことが重要である。

## [0045]

次に、弾性表面波素子1とベース基板2とを電気的に接続するハンダパンプ部材3及び周囲を封止するハンダ接合部材4を形成する(図3(b)参照)。このハンダバンプ部材3及びハンダ接合部材4は、大型ベース基板の各素子領域に形成した素子接続用電極21の表面及び外周封止導体膜22の表面に、ペースト状のハンダを塗布して形成する。なお、バンプ状とするため、塗布したハンダを1次加熱処理、洗浄処理をおこなう。これにより、印刷したハンダは、素子接続電極21及び外周封止導体膜22上で断面半円形状となり、さらに、不要なフラックス成分を除去することができる。

## [0046]

このハンダバンプ部材3及びハンダ接合部材4は、ベース基板20側に形成している。これは弾性表面波素子1側に形成する場合、非常に狭い間隔のIDT電極11にハンダやその他の不要な成分が付着して、弾性表面波素子1の特性劣化を避けるためである。

# [0047]

また、タンタル酸リチウム圧電基板10が複数抽出できるタンタル酸リチウムの大型圧電基板を用意する。この大型圧電基板の一方主面の各素子領域には、IDT電極11、接続電極12、外周封止電極13が被着形成される。そして、各大型圧電基板は、各弾性表面波素子1毎に切断処理され、その後、例えば整列パレットなどに整列される。このタンタル酸リチウム圧電基板10の一方主面に、図1に示すように、IDT電極11が形成され、さらにこのIDT電極11と接続をする接続電極12が形成され、さらIDT電極11及び接続電極12を取り囲むように、基板10の周辺には外周封止電極13が形成されている。

#### [0048]

次に、パレットに整列した弾性表面波素子1を取り出して(図3 (c)参照) 、大型ベース基板の各基板領域に載置する。このとき、弾性表面波素子1側の接 続電極12と、基板領域の素子接続用電極21上に形成したハンダバンプ材3と を位置合わせして、同時に、弾性表面波素子1の外周封止電極13と各基板領域 に形成した外周封止導体膜22上に形成したハンダ接合部材4と位置合わせをお こなう。これにより、大型ベース基板には、各基板領域に対応して弾性表面波素 子1がそれぞれ載置されることになる(図3(d)参照)。

# [0049]

次に、弾性表面波素子1が載置された大型ベース基板を一括的にリフロー処理して、このハンダパンプ部材3によって電気的な接続を施し、ハンダ接合部材4によって両者を機械的に接合するとともに気密的に封止をおこなう。これにより、ハンダパンプ部材3及びハンダ接合部材の4の高さに相当する間隙が、弾性表面波素子1の一方主面と大型ベース基板の表面との間に形成でき、弾性表面波素子1で発生する弾性表面波を安定して伝搬させることができる。なお、このリフロー処理時に、その雰囲気を例えば窒素雰囲気中で処理することにより、この間隙を窒素雰囲気にすることができる。

## [0050]

次に、大型ベース基板に電気的な接続及び機械的な接合が施された弾性表面波素子1に、素子1の他方主面(露出している表面)側から、外装樹脂層5となる例えばエポキシ樹脂ペーストを塗布して、硬化処理する。この時、弾性表面波素子1よりも大型ベース基板の各素子領域の平面形状が大きいため、隣接しあう弾性表面波素子1の間隙にもエポキシ樹脂が塗布される。即ち、弾性表面波素子1は、他方主面側及びその側面に外装樹脂層5が塗布されることになる(図3(e)参照)。

#### [0051]

次に、複数の弾性表面波素子1が実装され、且つ外装樹脂層5が被着された大型ベース基板を、基板領域毎に外装樹脂層5が被着された状態でダイシング処理により切断処理する(図3(f)参照)。この工程により、図1、図2に示す弾性表面波装置が得られることになる。

#### [0052]

本発明において、ハンダパンプ部材3及びハンダ接合部材4に、90%以上の Sbを含むSn-Sb系またはSn-Ag系のハンダを用いている。例えば、S

## [0053]

その結果を図4に示す。図4においては、Sn-Pbハンダは環境的配慮すると実用性に乏しく、また、鉛成分含有による最大主応力は小さいものの、逆に温度サイクル試験などを施すと、金属疲労をおこしてしまい、接合信頼性の低下を招いてしまう。また、Sn-Au系ハンダは、降伏応力が高すぎてしまう。その結果、ベース基板2に接合した時に、ハンダ接合部材4に残留する応力が、弾性表面波素子1に影響し、例えば、最大主応力が200N/mm²を超えると、弾性表面波素子1をベース基板2に接合した状態で、また、温度サイクル試験で、弾性表面波素子1にクラックが発生してしまうことを確認している。即ち、最大主応力は、ハンダ接合部材4の封止幅によっても依存するため、接合に用いるハンダ材料と封止幅とを調整して、ハンダ接合部材4における最大主応力の値が、200N/mm²を超えないように、図4に基づいて設定する必要がある。

#### [0054]

以上のことから、ハンダ接合部材4のハンダとしては、Sn-Sb系またはSn-Ag系のハンダを用いることが重要である。また、Snが組成中90%以上存在していないと、ハンダ接合が安定して行えない。なお、ハンダバンプ部材3は、上述のように、ハンダ接合部材4と同一工程で形成し、同一工程で接続する。このため、ハンダバンプ部材3をハンダ接合部材4と同一組成にしておくことが、ハンダバンプ部材3及びハンダ接合部材4の取り扱いが容易となる。

#### [0055]

本発明者は、Sn-Sb系ハンダ、Sn-Ag系ハンダを用いて、タンタル酸リチウム圧電基板 10 (タンタル酸リチウムの熱膨張係数は  $16ppm/\mathbb{C}$ であるものの、表面波伝播方向の線膨張係数は約  $16ppm/\mathbb{C}$ 、表面波伝播方向と直交する方向の線膨張係数は約  $8.3ppm/\mathbb{C}$ )を接合するあたり、最適なべ

## ース基板2を検討した。

[0056]

本発明は、ベース基板2の熱膨張係数を $7\sim25$ をp p m/ $\mathbb C$ の範囲に属する5種類の基板材料を用いて、ハンダ材料として、S n - A g  $\mathfrak R$   $\mathfrak$ 

[0057]

その結果、図 5 に示すように、塑性ひずみ量と平均故障寿命とは、明らかな相関関係が得られ、具体的には、ベース基板 2 の熱膨張係数が  $9\sim2$  0 p p m/ $\mathbb C$  であると、塑性ひずみ量が 2. 0 %未満とすることができ、これにより、平均故障寿命を約 1 0 0 0 回以上となる。

[0058]

これに対して9ppm/℃未満となると、ベース基板2と弾性表面波素子1の 熱膨張係数の差による応力が大きくなり、塑性ひずみ量が大きくなりすぎ、温度 サイル回数1000未満で故障してしまう。このような基板の材料としては、ア ルミナセラミック基板(7.1ppm/℃)が例示できる。この場合、接合直後 の弾性表面波素子1のクラックの発生率が30%を超え、さらに、温度サイクル 10回で2~3%の割合で弾性表面波素子1にクラックが発生してしまい、ベー ス基板2のひずみからも、また、接合部分の応力の関係からも、実用のレベルに いたらない。

[0059]

また、これに対して20ppm/℃を越えると、ベース基板2と弾性表面波素子1の熱膨張係数の差による応力が大きくなり、塑性ひずみ量が大きくなり過ぎ、温度サイル回数1000未満で故障してしまう。

なお、上述の9~20ppm/℃の範囲においては、アルミナセラミック粉末を 無機物フィラーとして用いて、その粉末の界面に結晶化ガラスを配したガラスセ ラミック基板が例示できる。そして、結晶化ガラスの組成、アルナミセラミック と結晶化ガラスとの非常により、比較的任意の熱膨張係数の基板得られる。

[0060]

本発明者は、10.6ppm/Cのベース基板2に、タンタル酸リチウム圧電基板10を用いた弾性表面波素子1を、Sn-Ag-Cu(96.5Sn-3.0Ag-0.5Cu)ハンダをハンダハンプ部材3及びハンダ封止部材4に用いた弾性表面波装置を作成した。なお、外装樹脂層5には、エポキシ樹脂を用いてその熱膨張係数を30ppm/C、ヤング率 $660kgf/mm^2$ とした。

[0061]

その結果、接合前の最大主応力が約137N/mm<sup>2</sup>となり、接合後(塑性ひずみの発生後)の応力が約78N/mm<sup>2</sup>となり、封止後における弾性表面波素子1のクラック及び温度サイクル試験10回後においても、弾性表面波素子1のクラックが共に発生しない。また、温度サイクル試験における平均故障寿命1700回であった。

[0062]

また、 $12.3ppm/\mathbb{C}$ のベース基板2に、タンタル酸リチウム圧電基板10を用いた弾性表面波素子1を、Sn-Ag-Cu(96.5Sn-3.0Ag-0.5Cu)ハンダをハンダハンプ部材3及びハンダ封止部材4に用いた弾性表面波装置を作成した。なお、外装樹脂層5には、エポキシ樹脂を用いてその熱膨張係数を $30ppm/\mathbb{C}$ 、ヤング率 $6468N/mm^2$ とした。

[0063]

その結果、接合前の最大主応力が約98N/mm<sup>2</sup>となり、接合後(塑性ひずみの発生後)の応力が約68N/mm<sup>2</sup>となり、封止後における弾性表面波素子1のクラック及び温度サイクル試験10回後においても、弾性表面波素子1のクラックが共に発生しない。また、温度サイクル試験における平均故障寿命1800回であった。

[0064]

なお、タンタル酸リチウム圧電基板10は熱膨張係数は、16ppm/℃であるものの、表面波伝播方向の線膨張係数は約16ppm/℃、表面波伝播方向と

直交する方向の線膨張係数は約8.3 p p m / ℃である。しかし、上述の種々の検討から、熱膨張係数は伝搬方向の16.0 p p m / ℃が支配的であり、その結果、ベース基板2の熱膨張係数の範囲の中心値14.9 4 は、タンタル酸リチウム圧電基板10の方向性を考慮した相加平均的な12.15 p p m / ℃に比較して、若干高い値となっている。このように設定すれば、タンタル酸リチウム圧電基板10の熱膨張係数が方向によって相違しても、実施的に方向性を無視して、ベース基板2、ハンダバンプ部材3、ハンダ接合部材4においては、上述のようなハンダ材料と、ベース基板との組み合わせにより、安価で、製造方法が容易な弾性表面波装置となる。

[0065]

## 【発明の効果】

以上のように、本発明では、タンタル酸リチウム圧電基板を用いた弾性表面波素子をベース基板にハンダパンプ部材に電気的に接続し、且つハンダ接合部材によって気密的に接合した弾性表面波装置であって、上述のハンダバンプ及びハンダ接合部材は、90%以上のSnを含むSn-Sb系またはSn-Ag系の無鉛ハンダであるとともに、前記ベース基板の熱膨張係数が、9~20ppm/℃としたため、熱膨張係数の差による熱応力に対して非常に安定して接合でき、しかも、長期にわたり安定した接続が維持できる弾性表面波装置となる。

#### 【図面の簡単な説明】

#### 【図1】

本発明の弾性表面波装置の断面構造図である。

#### 【図2】

本発明の弾性表面波装置に用いるベース基板の平面図である。

#### 【図3】

(a)~(f)は、本発明の弾性表面波装置の製造方法の各工程を説明する断面図である。

#### 【図4】

ハンダ組成の違いによる最大主応力の比較した特性図である。

#### 【図5】

基板の熱膨張係数による塑性ひずみ量及び平均寿命との関係を示す特性図である

# 【図6】

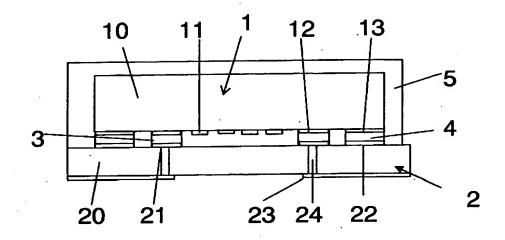
従来の弾性表面波装置の断面図である。

## 【符号の説明】

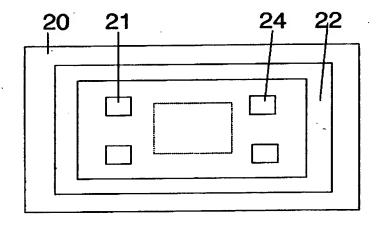
- 1 弹性表面波素子
- 2 ベース基板
- 10 タンタル酸リチウム圧電基板
- 11 IDT電極
- 12 接続電極
- 13 外周封止電極
- 20 基板
- 21 素子接続用電極
- 22 外周封止導体膜
- 23 外部端子電極
- 24 内部配線パターン
- 3 ハンダバンプ部材
- 4 ハンダ接合部材
- 5 外装樹脂層

【書類名】 図面

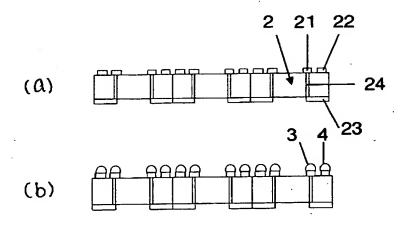
# 【図1】

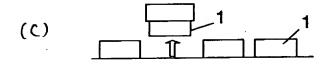


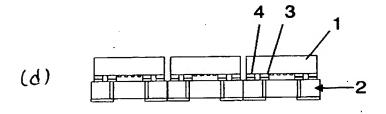
【図2】

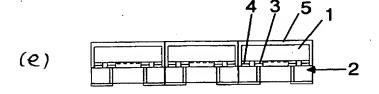


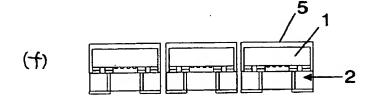
【図3】



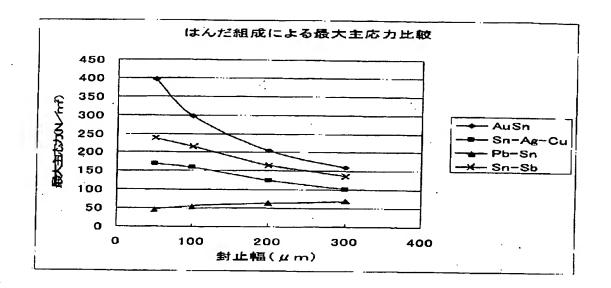




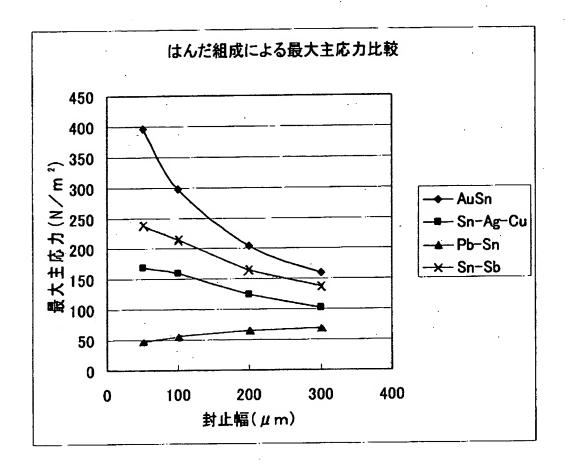




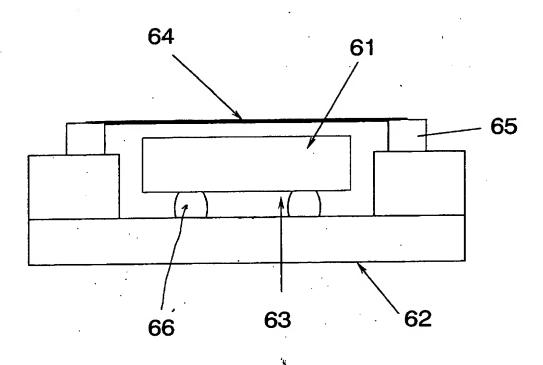
【図4】



【図5】



【図6】





## 【要約】

【課題】本発明は、熱膨張係数の差による熱応力に対して非常に安定して接合でき、長期にわたり安定した接続が維持できる弾性表面波装置を提供する。

【解決手段】 本発明は、タンタル酸リチウム圧電基板10の一主面上にIDT 電極11、接続電極12及び外周封止電極13が形成された弾性表面波素子と、

ハンダバンプ部材3を介して前記接続電極と接続する素子接続用電極21、ハンダ接合部材4を介して前記外周封止電極13と接合する外周封止導体膜22を形成されたベース基板2とからなる弾性表面波装置である。そして、ハンダバンプ部材3及びハンダ接合部材4は、90%以上のSnを含むSn-Sb系またはSn-Ag系の無鉛ハンダを用い、前記ベース基板2の熱膨張係数が、9~20ppm/℃に設定した。

## 【選択図】図1

# 認定・付加情報

特許出願の番号

特願2002-222582

受付番号

 $5\ 0\ 2\ 0\ 1\ 1\ 2\ 9\ 5\ 3\ 7$ 

書類名

特許願

担当官

第七担当上席 0096

作成日

平成14年 8月 1日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成14年 7月31日

# 出願人履歴情報

識別番号

(000006633)

1. 変更年月日

1998年 8月21日

[変更理由]

住所変更

住 所

京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地

氏 名

京セラ株式会社